

整理番号 EP-0320101

発送番号 151574

発送日 平成15年 5月 6日

1 / 2

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2001-330784
起案日	平成15年 4月30日
特許庁審査官	正山 旭 9276 4M00
特許出願人代理人	井上 一 (外 2名) 様
適用条文	第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理由

A. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1 ~ 15
- ・理由 A
- ・引用文献等 1, 2, 3
- ・備考

4層の導電層でCMOS型SRAMセルを形成することについては、引用文献1の、特に、第1図~第8図及び図面説明箇所を参照されたい。

負荷トランジスタにおけるゲートーゲート電極層の幅が駆動トランジスタにおけるゲートーゲート電極層の幅よりも大きいことについては、引用文献2の、特に、第1図及び図面説明箇所を参照されたい。

請求項3, 4の、不純物層上に形成されるコンタクト部については、引用文献3の、特に、第2図及び図面説明箇所を参照されたい。

引用文献等一覧

- 1.特開2000-269319号公報 /
- 2.特開平11-017028号公報
- 3.特開2000-208643号公報

B. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

記

・請求項11

本請求項には、「前記第1層導電層」、「前記第2層導電層」及び「前記第3層導電層」という記載があるが、「前記」に対応する文言がない。

・請求項12、13

本請求項には「第2層導電層」という記載があるが、「第2層導電層」が何かの説明がない。

・請求項14、15

本請求項は、不明瞭な記載を有する請求項11～13を引用しているため、同様に不明瞭である。

よって、請求項11～15に係る発明は明確でない。

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 I P C 第7版 H 01 L 27 / 11
H 01 L 21 / 8244

・先行技術文献

特開平07-231044号公報 /
特開平09-260510号公報 /

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2001-333097
起案日	平成15年 4月22日
特許庁審査官	正山 旭 9276 4M00
特許出願人代理人	井上 一(外 2名) 様
適用条文	第29条第2項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

A. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13
- ・理由 A
- ・引用文献等 1, 2, 3
- ・備考

引用文献1の、特に、第1図～第8図及び図面説明箇所を参照されたい。
 また、引用文献2（特に第1図、第2図参照）に記載されているように、P、Nのウエル領域の境界はPN活性領域のほぼ中間にあることは一般的であるから
 引用文献1において、第2ドレインーゲート配線層の上層部が、Pウエル領域及びNウエル領域のいずれかの領域の上方に設けられていると認められる。

なお、ドレインーゲート配線がNウエル領域側に設けられていることについては、引用文献3の、第6図及び図面説明箇所を参照されたい。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

